

2008 第18回 RCJ信頼性シンポジウム

(電子デバイスの信頼性シンポジウム、EOS/ESD/EMCシンポジウム)

全体プログラム

日時： 2008年10月30日(木)～10月31日(金)

開催場所：大田区産業プラザ

日時	10月30日(木)		10月31日(金)	
項目	電子デバイスの信頼性 シンポジウム、 優秀論文等表彰式	EOS/ESD/EMC シンポジウム	電子デバイスの信頼性 シンポジウム	EOS/ESD/EMC シンポジウム
会場	4階コンベンションホール		4階コンベンションホール	
	A会場	B会場	A会場	B会場
午前	(10:00～12:00) 招待講演	(10:00～12:00) 「半導体ESD チュートリアル」	(10:00～12:00) 信頼性セミナー	(10:00～12:00) 「パネルディスカッション」
昼	(12:00～12:15) 優秀論文等表彰式 (12:15～13:15) 懇親会(1階展示場脇)		(12:00～13:00) 休憩	(12:00～12:40) 休憩
午後 前半	(13:30～16:00) 「部品・デバイスの 信頼性評価」	(13:30～14:30) 「招待講演」	(13:00～16:50) 信頼性セミナー	(12:40～14:20) 「イミュニティ関連」
午後 後半	(16:15～17:45) 「先端CMOS LSIの 信頼性」	(14:40～17:50) 「半導体デバイスのESD」	「NBTIと最近の 信頼性話題」	(14:40～17:00) 「ESDコントロール技術」
展示会	(10:00～17:00) (1階大展示ホール)		無し	

主催 財団法人 日本電子部品信頼性センター

協賛 社団法人 電子情報技術産業協会 社団法人 日本電機工業会

(順不同) 社団法人 日本電気計測器工業会 財団法人 日本規格協会

社団法人 日本電子回路工業会 財団法人 日本科学技術連盟

財団法人 光産業技術振興協会 日本信頼性学会

財団法人 ベンチャーエンタープライズセンター 社団法人 日本応用磁気学会

IDEMA JAPAN

社団法人 電子情報通信学会

社団法人 電気学会

社団法人 静電気学会

情報通信ネットワーク産業協会

SPE日本支部

参加のお勧め

RCJ信頼性シンポジウムは、電子部品、電子デバイス、電子機器等の信頼性技術者・生産技術者を対象に、信頼性及びESDという共通のテーマで論文発表・討論しあい、より進歩した信頼性向上技術、ESD障害対策技術等の分野での発展に寄与することを狙いとしています。本シンポジウムは、電子デバイスの信頼性問題を中心に扱う電子デバイスの信頼性シンポジウム及び静電気関連問題を中心に扱うEOS/ESD/EMCシンポジウムからなっています。

今年で、18回目を迎えました。今年は、装置のイミュニティ問題を含め、例年通りESD対策技術に関する多数の論文投稿を頂きました。また、昨年好評を頂きました半導体デバイスのESD現象に関するチュートリアル、及びパネルディスカッションを今年も設けました。また、電子デバイスの信頼性評価技術及び鉛フリーはんだ実装の信頼性に関する発表等もあります。

さらに、同会場1階大展示場で、静電気(ESD)対策用資材、計測・評価試験装置及び半導体LSI等の環境試験装置、故障解析技術サービス等をテーマとした“信頼性・ESD対策技術展示会”を同時開催いたします。今年も、昨年好評頂きました“ESD対策モデルルーム”の展示を、内容を充実して行います。

日頃、この方面でご活躍の皆様の多数のご参加をお勧め致します。

(2008.9.30改)

最新版プログラムは RCJ ホームページ(<http://www.rcj.or.jp>)をご覧ください。

第18回 電子デバイスの信頼性シンポジウム、優秀論文等表彰式

開催日: **2008年10月30日(木)** 10:00~17:45

会場: 4階コンベンションホール(A会場)

開会の挨拶(10:00~10:05)		久保 陽一 (RCJ 専務理事)
セッション名: 招待講演		司会 久保 陽一 (RCJ 専務理事)
(10:05~11:00)	招待	「シリコンナノエレクトロニクスの将来展望」 平本 俊郎 (東京大学 生産技術研究所)
(11:00~12:00)	招待	「電気製品の事故究明と長期使用における課題」 井原 惇行 (楠本化成 (株))
第17回RCJ信頼性シンポジウム優秀論文賞等表彰式 (12:00~12:15)		
挨拶		木村 忠正 (電気通信大学教授 RCJ信頼性シンポジウム運営委員長)
表彰式		木村 忠正 (RCJ信頼性シンポジウム運営委員長)
<優秀論文賞>		
「RC-Triggering 電源クランプ素子小面積化技術の開発」 石塚 裕康、大塚 容子、池田 裕之、豊嶋 俊輔、田中 一雄 ((株)ルネサステクノロジー)		
<技術賞>		
「プリント配線板における CAF 現象の調査と評価法の検討」 中村 和裕 (新光電気工業 (株))		
<奨励賞>		
「金属電極間のESDにおける放電電流波形と放射電磁ノイズの電波吸収材を用いた検討(Ⅱ)」 吉田 孝博、隅田 淳、増井 典明 (東京理科大学 工学部電気工学科)		
懇親会(12:15~13:15) (場所:1階大展示場)		
RCJ信頼性シンポジウム参加の皆様は自由にご出席下さい(無料)。		
セッション名: 部品・デバイスの信頼性評価		座長: 穴山 汎 (RCJ)
(13:30~14:00)	18S-01	「はんだ実装のための Au 表面 Ni 拡散量評価方法の検討」 高野 みどり (パナソニック エレクトロニックデバイス (株))
(14:00~14:30)	18S-02	「銀エポキシ系導電性接着剤の実装信頼性評価」 田中 浩和、平田 拓哉、中川 泰利 (エスペック (株))
(14:30~15:00)	18S-03	「鉛フリーはんだ Sn-3.0mass%Ag-0.5mass%Cu, Sn-3.5mass%Ag-8.0mass%In-0.5mass%Bi 接合信頼性」 西村 雅史 ^{*1} 、堂蘭 重隆 ^{*2} 、西浦 正孝 ^{*1} 、澤田 裕之 ^{*1} 、桐村 和行 ^{*1} (* ¹ パナソニック エレクトロニックデバイス (株)) (* ² パナソニック エレクトロニックデバイス ジャパン (株))
(15:00~15:30)	18S-04	「鉛フリーはんだの腐食性の検討」 佐々木 喜七 ¹ 、津久井 勤 ² 、山本 克己 ³ 、石川 一也 ⁴ (¹ RCJ、 ² リサーチラボ・ツクイ、 ³ テクノオフィス ヤマモト、 ⁴ アルプス電気)
(15:30~16:00)	18S-05	「HAST におけるプリント配線板の酸化現象と影響」 中村 和裕 (新光電気工業 (株))
休憩(16:00~16:15)		
セッション名: 先端 CMOS LSI の信頼性		座長: 大日方 浩二 (ソニー(株))
(16:15~16:45)	18S-06	「潜在性不可視欠陥による low- κ 絶縁膜 TDDB の初期故障予測: Yield-Reliability モデルの実験的検証」 横川 慎二、押田 大介、土屋 秀昭、泰地 稔二、森田 敏文、 土屋 泰章、竹脇 利至 (NEC エレクトロニクス(株))
(16:45~17:15)	18S-07	「DC Pulse NBTIによる特性変動量予測についての考察」 川井 望 ((株)東芝セミコンダクター社)
(17:15~17:45)	18S-08	「HfSiO _x ゲート絶縁膜の TDDB 特性に関する一考察」 宇野 哲史、矢神 義之、林 朋彦、清水 立雄、加藤 一郎、横川 慎二 (NEC エレクトロニクス(株))

第18回 電子デバイスの信頼性シンポジウム(続き)

開催日: 2008年10月31日(金) 10:00~16:40

会場: 4階コンベンションホール(A会場)

信頼性セミナー: NBTI(負バイアス温度不安定性)と最新の信頼性話題

司会: 木村 忠正 (電気通信大学)		
(10:00~10:30)	「故障物理委員会活動の概要と最近の話題」	木村 忠正 (電気通信大学:故障物理委員会委員長)
(10:30~12:00)	「システムLSIの信頼性」	瀬戸屋 孝 (株)東芝セミコンダクター社
昼食休憩(12:00~13:00)		
司会: 大日方 浩二 (ソニー (株))		
(13:00~13:50)	「先端デバイスのNBTI劣化現象」	大日方 浩二 (ソニー(株) 半導体事業本部)
(13:50~14:40)	「最新high- κ /メタルゲートのNBTI」	塩野 登 (RCJ)
休憩(14:40~15:00)		
(15:00~15:50)	「NBTIの回路特性への影響」	中野 真治 (松下電器産業(株) 半導体社)
(15:50~16:40)	「low- κ 膜のTDDB」	横川 慎二 (NECエレクトロニクス(株))

(注: テーマ名等プログラムが変更される場合があります)

<要旨>

LSIの微細化と連動して常に問題となってきた信頼性の課題は、ゲート酸化膜の経時絶縁破壊(TDDB)、配線のエレクトロマイグレーション(EM)およびストレス誘起ボイド形成(SIV)、ホットエレクトロン(HC)に起因する特性劣化、負バイアス温度不安定性(NBTI)などの摩耗故障である。ゲート酸化膜が2nmを切りTDDBの故障メカニズムや故障の特性が大きく変わり、また、Cu配線材料の導入によりストレス誘起ボイド形成による故障が現れ、その対策に、ここ数年の間、信頼性研究者、技術者の多大な苦勞と貢献がありました。

45nmノード以降の高性能・高集積化技術では、単なる微細化ではなく、新素材と新しいデバイス構造の採用が必要となっています。その代表例がhigh- κ ゲート絶縁膜、low- κ 層間膜、マルチゲート構造です。このような新素材・新デバイス構造は、信頼性にも大きな影響を与え、この技術開発では、信頼性検討・対策も重要な要素となっています。

主な信頼性上の課題は、①ストレスが増加する(一般に微細化(スケールアップ(寸法縮小))よりは、電源電圧の低下は難しく、スケールアップにより配線に流れる電流密度、配線間やゲート絶縁膜に印加される電界強度は増加する傾向にある。)、②新しい素材、プロセス、デバイス構造の採用では、新しい故障モードが現れる、③加速寿命試験の効率が低下し、スクリーニング効率も低下する(実使用電圧と寿命試験やスクリーニング(バーンイン)時に印加可能なストレス電圧との差が小さくなり、電圧加速性が小さくなる。また実使用時の接合温度も高くなり、寿命試験やバーンイン温度との差が小さくなり、温度加速性も小さくなる)などです。

本セミナーでは、以上の課題のなかで、最近最も信頼性上重要な問題となっているNBTI(負バイアス温度不安定性)について、劣化現象の特徴、高速測定方法、high- κ の問題、回路への影響等について解説します。さらに、配線層間膜のlow- κ 膜の信頼性、システムLSI全般にわたる信頼性についても報告します。なお、本セミナーは、RCJ故障物理研究委員会の活動成果を中心に報告するものです。半導体デバイス信頼性に携わっている多くの方々のご参加をお勧めします。

第18回 EOS/ESD/EMCシンポジウム プログラム

開催日: **2008年10月30日(木)** 10:00~17:50

会 場: 4階コンベンションホール(B会場)

チュートリアル: ESD評価方法と保護設計技術(ESDの基礎的な解説も含まれる)(注:変更のある場合あり)

司会: 福田 保裕 (沖エンジニアリング(株))		
(10:00~10:30)	「ESD現象」	福田 保裕(沖エンジニアリング(株))
(10:30~11:00)	「ESD試験方法の動向」	磯福 佐東至(東京電子交易(株))
(11:00~11:30)	「ESD破壊現象」	石塚 裕康((株)ルネサステクノロジ)
(11:30~12:00)	「ESD保護方法」	森下 泰之(NECエレクトロニクス(株))

セッション名: 招待講演(半導体デバイスのESD)		
座長: 澤田 真典(阪和電子工業(株))		
(13:30~14:00)	招待	2007年米国EOS/ESDシンポジウム優秀論文(予定) 「Harmful voltage overshoots due to turn-on behaviour of ESD protections during fast transients」 T. Smedes, N. Guitard, NXP Semiconductors (Netherlands)
(14:00~14:30)	招待	「On-wafer Human Metal Model - system level ESD stress on component level」 M. Schlz, D. Linten, S. Thijs, M. Sawada, T. Nakaie, T. Hasebe, G. Groseneken IMEC, Hanwa Electronic Ind. Co.,Ltd
休憩(14:30~14:40)		
セッション名: 先端半導体デバイスのESD(1) 座長: 森下 泰之(NECエレクトロニクス(株))		
(14:40~15:00)	18E-01	「LCD パネルモジュール組み立て工程におけるESD 現象」 下村 奈良和、上山 浩一、三本 敏雄 (シャープ(株) 電子デバイス事業本部)
(15:00~15:20)	18E-02	「先端CMOS技術におけるESD破壊現象」 田中 正徳、河内 福賢、森下 泰之 (NECエレクトロニクス(株))
(15:20~15:40)	18E-03	「半導体デバイスのデバイス帯電系ESD 試験方法の検討」 三口 宗彦、片岡 資晴、中野 真治、和田 哲明 (松下電器産業(株) 半導体社)
(15:40~16:00)	18E-04	「TEGと製品とのCDM結果比較により見出されたCDMの盲点について」 鈴木 輝夫 ⁽¹⁾ 、小島 正誉 ⁽¹⁾ 、橋本 賢治 ⁽²⁾ 、Bart Sorgeloos ⁽³⁾ 、Olivier Marichal ⁽³⁾ 、 Bart Keppens ⁽³⁾ ⁽¹⁾ 富士通VLSI(株)、 ⁽²⁾ 富士通マイクロエレクトロニクス(株)、 ⁽³⁾ Sarnoff Europe BVBA
(16:00~16:20)	18E-05	「CDMにおける放電電流解析と耐性比較」 石塚 裕康、池田 博之、田中 一雄 (ルネサステクノロジ(株))
休憩(16:20~16:30)		
セッション名: 先端半導体デバイスのESD(2) 座長: 若井 伸之((株)東芝セミコンダクター社)		
(16:30~16:50)	18E-06	「Solving the problems with traditional Silicon Controlled Rectifier (SCR) approaches for ESD」 Yasuhiro Fukuda ⁽¹⁾ , Toshikazu Kuroda ⁽¹⁾ , Koen Verhaege ⁽²⁾ and Bart Keppens ⁽²⁾ (1) Oki Engineering Co., Ltd., (2) Sarnoff Europe BVBA
(16:50~17:10)	18E-07	「Analysis Methodology for Latch-up: Realistic Worst Case Stress Conditions for the Current Injection 'I-test」」 Geert Wybo ⁽¹⁾ , Hideaki Matsumoto ⁽²⁾ , Hitoshi Matsueda ⁽²⁾ , Sven Van Wijmeersch ⁽¹⁾ , Stefaan Verleye ⁽¹⁾ , Olivier Marichal ⁽¹⁾ and Bart Keppens ⁽¹⁾ (1) Sarnoff Europe BVBA, (2) New Japan Radio Co., Ltd
(17:10~17:30)	18E-08	「高耐压系ESDインフラ保護素子のラッチアップ試験における破壊現象」 中嶋伸恵、石塚裕康、中野浩二、鹿山正規、加藤悟 (ルネサステクノロジ(株))
(17:30~17:50)	18E-09	「TLP測定によるESDパラメータ抽出」 福田 保裕 ⁽¹⁾ 山田 朋美 ⁽¹⁾ 澤田 真典 ⁽²⁾ (⁽¹⁾ 沖エンジニアリング(株), ⁽²⁾ 阪和電子工業(株))

第18回 EOS/ESD/EMCシンポジウム プログラム(続き)

開催日: 2008年10月31日(金) 10:00~17:00

会場: 4階コンベンションホール(B会場)

(10:00~12:00)	<p>パネルディスカッション: 「ESD現象と今後のデバイスESD保護対策」</p> <p>趣旨: 今後のESD問題は、デバイス製造からデバイスを組み込んだシステムレベルまで、広範囲に渡る。それらのESD現象に対する今後のデバイスESD保護対策を中心ディスカッションする。</p> <p>コーディネーター: 福田 保裕 (沖エンジニアリング(株))、川島 博文(ソニー(株))</p> <p>パネリスト:</p> <p>Bart Keppen(Sarnoff Europe)</p> <p>若井 伸之(株)東芝セミコンダクター社)</p> <p>鈴木 輝夫(富士通VLSI(株))</p> <p>磯福 佐東至(東京電子交易)</p> <p>(詳細プログラムは後日お知らせ致します)</p>
---------------	---

セッション名: イミュニティ関連 座長: 渡辺 毅 ((株)NECエレクトロニクス)	
(12:40~13:00)	<p>18E-10 「同期型TLP印加装置によるイミュニティ解析手法」</p> <p>松井 信近¹、中家 利幸¹、塚越 常雄²、渡辺 毅³</p> <p>(¹阪和電子工業(株)、²日本電気(株)、³NECエレクトロニクス(株))</p>
(13:00~13:20)	<p>18E-11 「ICカードのEMC試験(近接型)」</p> <p>白井 秀泰 (沖エンジニアリング(株))</p>
(13:20~13:40)	<p>18E-12 「帯電極性と放電時のインパルス極性の関係」</p> <p>本田 昌實 ((株)インパルス物理研究所)</p>
(13:40~14:00)	<p>18E-13 「金属電極間放電で発生する放射電磁ノイズに影響を及ぼす放電電流の振動成分について(Ⅱ)」</p> <p>河崎 健太郎, 吉田 孝博, 増井 典明 (東京理科大学 工学部電気工学科)</p>
(14:00~14:20)	<p>18E-14 「接地電極形状が人体からの静電気放電に及ぼす影響(Ⅱ)」</p> <p>吉原 宏, 吉田 孝博, 増井 典明 (東京理科大学 工学部電気工学科)</p>
休憩(14:20~14:40)	
セッション名: ESDコントロール技術 座長: 本田 昌實 ((株)インパルス物理研究所)	
(14:40~15:00)	<p>18E-15 「除電装置の高機能化とイオン輸送」</p> <p>村崎 憲雄 (東京農工大学 名誉教授)</p>
(15:00~15:20)	<p>18E-16 「イオン核凝縮を利用した荷電粒子搬送式イオナイザーの開発 その2」</p> <p>鈴木 政典、松田 喬 ((株)テクノ菱和 技術開発研究所)</p>
(15:20~15:40)	<p>18E-17 「AC コロナ放電型イオナイザの動作条件と除電電流分布との関係」</p> <p>田中 伸一郎、吉水 健剛、岡野 一雄 (職業能力開発総合大学校)</p>
(15:40~16:00)	<p>18E-18 「AC コロナ放電型イオナイザの除電電流測定用センサ」</p> <p>榎園 昌弘、田辺 敏雄、吉水 健剛、岡野 一雄 (職業能力開発総合大学校)</p>
(16:00~16:20)	<p>18E-19 「Controlling Static Charge to Eliminate CDM ESD Damage」</p> <p>Arnie Steinman (MKS, Ion Systems)</p>
(16:20~16:40)	<p>18E-20 「HGAアンテナモデルによるEMIノイズ観測とGMR/TMR破壊現象」</p> <p>仲島 智秀 (富士通株式会社)</p>
(16:40~17:00)	<p>18E-21 「ハードディスク内部で発生する摩擦帯電のヘッド・フライングハイトへの影響」</p> <p>田中 克英 大塚 正樹 津波古 和司</p> <p>((株)日立グローバルストレージテクノロジーズ)</p>

信頼性・ESD 対策技術展示会(無料)

(静電気障害対策技術、信頼性評価技術及び故障解析技術を扱う専門の展示会)

静電気の影響を受けやすい電子デバイス・部品、電子機器などを扱う信頼性技術者、生産技術者の方々を対象に、より進歩した静電気障害対策技術、信頼性評価技術、故障解析技術を扱う専門の展示会です。多くの専門メーカーが展示しますので、最新の技術情報収集のためにも是非お役立て下さい。

期日：平成20年10月28日(火)～10月30日(木)：10:00～17:00

会場：大田区産業プラザ(東京 蒲田)1階大展示場

同時開催：ESD対策技術セミナー(無料:資料代有料)、信頼性・ESD対策技術ワークショップ(無料)
同会場内特設会場にて

ESD対策技術基礎セミナー(参加費無料、資料代3,000円)

- 本セミナーは、静電気現象の実験を交えて説明すると共に各種測定機器のデモンストレーションを行い、より実務的な分かり易い内容のセミナーとなっています(注：ESD COORDINATORセミナーとは関係ありません)。

日付	時間	講師	セミナーテーマ： ESD対策技術基礎
10月28日(火)	10:30~12:00	鈴木 輝夫 (春日電機株)	静電気現象と静電気対策(実演つき説明)
	13:00~14:30	川村 智紀 (ミドリ安全株)	人体接地関連用品他
10月29日(水)	10:30~12:00	水谷 智 (原田産業株)	ESD対策に使用される装置(イオナイザー)
	13:00~14:30	西畑 直光 (株クレハ)	ESDコントロール材料
10月30日(木)	10:30~12:00	佐土原 秀樹 (東京電子取引株)	デバイス試験 (ESD、CDM,ラッチアップ規格)
	13:30~15:00	高橋 忠 (トレック・ジャパン株)	計測と静電気対策(実演つき説明)

出展社による無料の信頼性・ESD対策技術ワークショップがあります。

トピックス：ESD対策モデルルームの展示(展示社が各資材・機器を持ちより、ESD対策モデルルームを展示します)

出展社名

アキレス(株)	(株)いけうち	沖エンジニアリング(株)
春日電機(株)	(株)クレハ	(株)コガネイ
(社)産業安全技術協会	シシド静電気(株)	(株)ダイフレックス
テク・トライアングル	(株)テクノスタート工業	東京電子取引(株)
トレック・ジャパン(株)	原田産業(株)	阪和電子工業(株)
ヒューグルエレクトロニクス(株)	松本技研(株)	ミドリ安全(株)
礼亜(有)	(財)日本電子部品信頼性センター	

★詳細は別途案内状をご覧ください。(RCJホームページ(<http://www.rcj.or.jp>)にも掲載しています)。

＜参加要領＞

参加区分(開催日)	テキスト	場所、 定員	参加費(消費税を含む)(円)	
			RCJ会員・ 協賛団体会員	非会員
①10月30日、10月31日: (2日間)	1) RCJ信頼性シンポジウム発表論文集 (電子デバイスの信頼性シンポジウム、EOS/ESD/EMCシンポジウム)	4階 A、B会場 300名	23,000	30,000
②10月30日:(1日間)	(注: 電子デバイス、EOS/ESD/EMCシンポジウム両方の聴講可能)		15,000	20,000
③10月31日:(1日間)	2) 平成19年度故障物理研究委員会成果報告書(信頼性セミナー用テキスト) (注:このテキストは希望者に配布します)		15,000	20,000

申込先: 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-13 新第一ビル TEL:03-3272-2736、FAX:03-3272-2926
(財)日本電子部品信頼性センター 総務部 E-mail: masunaga@rcj.or.jp

申込締切: 10月24日(金)

申込方法: 「参加申込書」を上記あて送付すると共に、「参加費」を現金書留又は銀行振込でご送金下さい。
銀行振込の手数料は、申込者負担です。銀行振込の場合は、振込内容(振込予定日(分かる場合: 貴社の都合に合わせて結構です)、金額、振込人名義)を参加申込書に明記して下さい。
なお、請求書及び領収書の発行を致しますので、必要な場合はその旨申込書にご記入下さい。
参加申込者には、参加券と関連資料を送付致します。シンポジウム発表論文集は当日配布となります。

振込銀行 三菱UFJ信託銀行、本店 普通預金口座 3546421

口座名: (財)日本電子部品信頼性センター

きりとり線

・FAXの場合は切り取らずこの用紙のままご送付下さい。

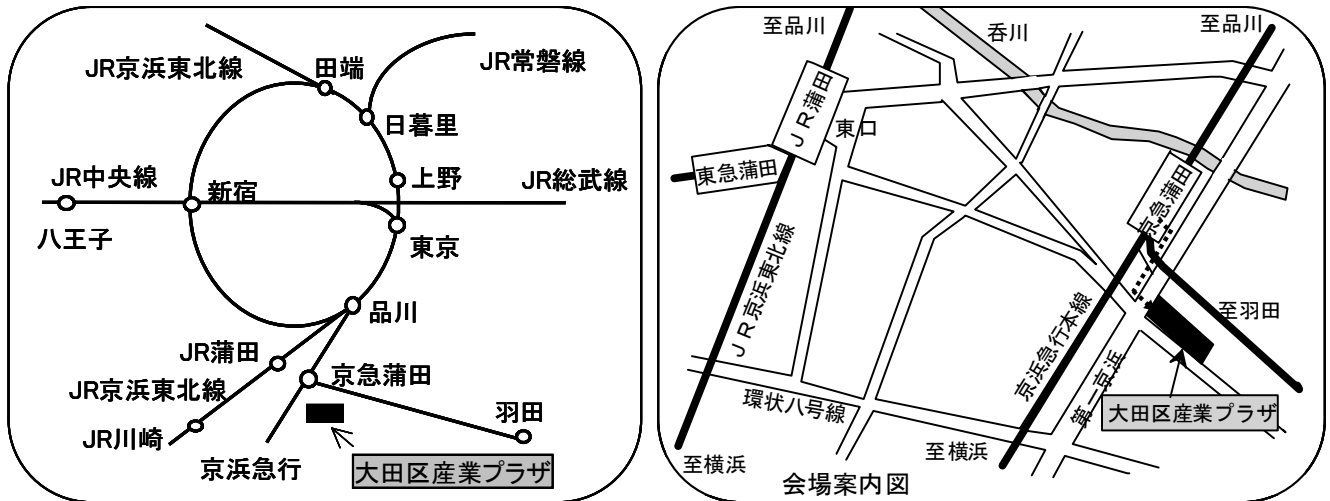
参加申込書

区分欄に上記表の①、②、③の参加区分を必ず記入して下さい。

会社名		所在地		会員又は否に○印を付けて下さい	
		〒		RCJ会員・ 協賛団体会員	否
		TEL			
*受理番号	区分	氏名	所属	平成19年度故障物理研究委員会成果報告書の要否 (該当箇所に○を付けて下さい)	
				要	不要
				要	不要
				要	不要
ご記入して下さい。 ●支払方法 現金書留／銀行振込 ●振込予定日 月 日 ●振込金額 円 ●振込人名義				備考(請求書、領収書の要否(該当箇所に○を付けて下さい)) 請求書 要 不要 領収書 要 不要	

*受理番号欄には、記入しないで下さい

◆会場ご案内



会場： 大田区産業プラザ： 4階コンベンションホール、1階大展示場
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20

交通： 京浜急行線・空港線/京急蒲田駅より徒歩約2分
(品川・横浜・羽田空港よりの所要時間各約10数分)
JR京浜東北線/蒲田駅より徒歩約12分

◆宿泊施設のご案内

遠方からお越しの方で宿泊が必要な場合下記のホテルに直接連絡してご利用下さい。

- (1) ホテル パネックス TEL: 03-5703-1111
東京都大田区蒲田5-9-19
 - (2) 東横イン 蒲田東口 TEL: 03-3736-1045
東京都大田区蒲田5-18-4
 - (3) 三井ガーデンホテル蒲田 TEL: 03-5710-1131
東京都大田区蒲田5-19-12
- 注) (1)、(2)、(3)ともJR蒲田駅東口徒歩2～3分程度